

請求の範囲

- [請求項1] 真空蒸着用のマスクの洗浄方法であって、
前記マスクを、N-メチル-2-ピロリジノン及びN, N-ジメチルホルムアミドから選ばれる少なくとも1種を含む洗浄組成物で洗浄し、
洗浄後の前記マスクを、 $\text{CF}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CF}_2\text{CHF}_2$ 、 $\text{CHF}_2\text{CF}_2-\text{O}-\text{CH}_3$ 、 $\text{CHF}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$ 及び $\text{CF}_3\text{CHF}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CF}_3$ から選ばれる少なくとも1種のハイドロフルオロエーテルを含むリンス組成物でリンスすることを特徴とする洗浄方法。
- [請求項2] 前記リンス組成物中の前記ハイドロフルオロエーテルの含有量の割合は、80質量%以上100質量%以下である、請求項1に記載の洗浄方法。
- [請求項3] 前記洗浄組成物は、N-メチル-2-ピロリジノンを含む、請求項1又は2に記載の洗浄方法。
- [請求項4] 前記リンス組成物は、 $\text{CF}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CF}_2\text{CHF}_2$ を含む、請求項1～3のいずれか一項に記載の洗浄方法。
- [請求項5] 前記マスクの洗浄及びリンスをいずれも10℃以上40℃以下で行う、請求項1～4のいずれか一項に記載の洗浄方法。
- [請求項6] 前記マスクの洗浄及びリンスをいずれも20℃以上30℃以下で行う、請求項1～5のいずれか一項に記載の洗浄方法。
- [請求項7] 前記真空蒸着は、低分子型有機EL素子の製造において行われる、請求項1～6のいずれか一項に記載の洗浄方法。
- [請求項8] 前記リンス組成物でリンスした後のマスクを乾燥させる、請求項1～7のいずれか一項に記載の洗浄方法。
- [請求項9] N-メチル-2-ピロリジノン及びN, N-ジメチルホルムアミドから選ばれる少なくとも1種を含む洗浄組成物で洗浄された真空蒸着用のマスクをリンスするリンス組成物であって、

$\text{CF}_3\text{CH}_2-\text{O}-\text{CF}_2\text{CHF}_2$ 、 $\text{CHF}_2\text{CF}_2-\text{O}-\text{CH}_3$ 、 $\text{CHF}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CHF}_2$ 及び $\text{CF}_3\text{CHFCH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CF}_3$ から選ばれる少なくとも 1 種のハイドロフルオロエーテルを含むことを特徴とするリンス組成物。

[請求項10] 前記リンス組成物中の前記ハイドロフルオロエーテルの含有量の割合は、80質量%以上100質量%以下である、請求項9に記載のリンス組成物。